

## PNP SILICON DUAL TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500 /336

### DEVICES

2N3810      2N3811  
 2N3810L    2N3811L  
 2N3810U    2N3811U

### LEVELS

JAN  
 JANTX  
 JANTV  
 JANS

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value		Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	60		Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	60		Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0		Vdc
Collector Current	$I_C$	50		mAdc
		One Section <sup>1</sup>	Both Sections <sup>2</sup>	
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	$P_T$	200	350	mW
Operating & Storage Junction Temperature Range	$T_J, T_{stg}$	-65 to +200		$^\circ\text{C}$



TO-78

### Note:

- Derate linearly 1.143mW/ $^\circ\text{C}$  for  $T_A > +25^\circ\text{C}$  (one section)
- Derate linearly 2.00mW/ $^\circ\text{C}$  for  $T_A > +25^\circ\text{C}$  (both sections)

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100\mu\text{Adc}$	$V_{(BR)CEO}$	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50\text{Vdc}$ $V_{CB} = 60\text{Vdc}$	$I_{CBO}$		10 10	$\eta\text{Adc}$ $\mu\text{Adc}$
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$ $V_{EB} = 5.0\text{Vdc}$	$I_{EBO}$		10 10	$\eta\text{Adc}$ $\mu\text{Adc}$



6 Lake Street, Lawrence, MA 01841  
 1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803  
 Website: <http://www.microsemi.com>

# TECHNICAL DATA SHEET

## PNP SILICON DUAL TRANSISTOR *Qualified per MIL-PRF-19500 /336*

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>ON CHARACTERISTICS</b>				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 10\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 100\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$  $I_C = 1.0\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 10\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 100\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$	2N3810, 2N3810L, 2N3810U     2N3811, 2N3811L, 2N3811U	$h_{FE}$     $h_{FE}$	100 150 150 125  75 225 300 300 250	450 450
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 100\mu\text{A}$ , $I_B = 10\mu\text{A}$ $I_C = 1.0\text{mA}$ , $I_B = 100\mu\text{A}$	$V_{CE(sat)}$		0.2 0.25	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 100\mu\text{A}$ , $I_B = 10\mu\text{A}$ $I_C = 1.0\text{mA}$ , $I_B = 100\mu\text{A}$	$V_{BE(sat)}$		0.7 0.8	Vdc
Base-Emitter Non-Saturation Voltage $V_{CE} = 5.0\text{A}$ , $I_C = 100\mu\text{A}$	$V_{BE}$		0.7	Vdc

### DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio, Magnitude $I_C = 500\mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ , $f = 30\text{MHz}$ $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ , $f = 100\text{MHz}$	$ h_{fe} $	1.0 1.0	5.0	
Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 10\text{Vdc}$ , $f = 1.0\text{kHz}$	$h_{fe}$	2N3810, 2N3810L, 2N3810U 2N3811, 2N3811L, 2N3811U	150 300	600 900
Small-Signal Short Circuit Input Impedance $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 10\text{Vdc}$ , $f = 1.0\text{kHz}$	$h_{je}$	2N3810, 2N3810L, 2N3810U 2N3811, 2N3811L, 2N3811U	3.0 3.0	30 40
Small-Signal Short Circuit Output Admittance $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 10\text{Vdc}$ , $f = 1.0\text{kHz}$	$h_{oe}$	2N3810, 2N3810L, 2N3810U 2N3811, 2N3811L, 2N3811U	5.0	60
Output Capacitance $V_{CB} = 5.0\text{Vdc}$ , $I_E = 0$ , $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	$C_{obo}$			5.0
Input Capacitance $V_{EB} = 5.0\text{Vdc}$ , $I_C = 0$ , $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	$C_{lbo}$			8.0



# TECHNICAL DATA SHEET

6 Lake Street, Lawrence, MA 01841  
 1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803  
 Website: <http://www.microsemi.com>

## PNP SILICON DUAL TRANSISTOR *Qualified per MIL-PRF-19500 /336*

### DYNAMIC CHARACTERISTICS (cont.)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Noise Figure				
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 100\text{Hz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F <sub>1</sub>		7.0	
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 1.0\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F <sub>2</sub>		3.0	dB
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 10\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F <sub>3</sub>		2.5	
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F <sub>4</sub>		3.5	
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 100\text{Hz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F <sub>1</sub>		4.0	
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 1.0\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F <sub>2</sub>		1.5	
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 10\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F <sub>3</sub>		2.0	dB
$I_C = 100\mu\text{A}$ dc, $V_{CE} = 10\text{V}$ dc, $f = 10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$ , $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F <sub>4</sub>		2.5	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.